

# 專利修正申請書範例 2

(本申請書格式、順序，請勿任意更動，※記號部分請勿填寫)

申請案號：100123456

※案 由：21002

依據：101 年 12 月 3 日 (101) 智專二(一)09999 字第 10021234560 號函辦理。

同時辦理事項：變更申請人之  地址  代理人  代表人  姓名或名稱

簽章  其他：

一、發明(新型或設計)名稱：半導體裝置之製造方法

二、申請人：(共 1 人) (多位申請人時，應將本欄位完整複製後依序填寫，姓名或名稱欄視身分種類填寫，依法不須填寫的部分可自行刪除)

(第 1 申請人)

國 籍： 中華民國  大陸地區 ( 大陸、 香港、 澳門)

外國籍：\_\_\_\_\_

身分種類： 自然人  法人、公司、機關、學校

ID：

姓名： 姓： 名：

Family  
name :

Given  
name :

(簽章)

名稱：(中文) 0000 股份有限公司

(英文) ABCD CO., LTD.

(簽章)

代表人：(中文) 000

(英文) 000

(簽章)

地址：(中文) 000000

(英文) 000000

聯絡電話及分機：

◎代理人：(多位代理人時，應將本欄位完整複製後依序填寫)

ID： Z123645879

姓名： 姓： OO 名： OO

(簽章)

證書字號： 台代字第 0000 號

地址： OO 市 OO 路 OO 號 OO 樓

聯絡電話及分機： (02)1234-5678 分機 0123

### 三、修正事項：

(請於所勾選、修正說明事項之後，敘明修正理由，如字數過多者，請另以 A4 紙張直式橫書繕打，以附件標示並備具 1 份，俾利審查。)

說明書修正之頁數、段落編號及行數及修正理由：

第 1 頁發明名稱

第 1 頁第[0004]段第 1 行、第 10 頁第[0052]段第 5 行

(修正理由請參申復說明書)

申請專利範圍修正之請求項及修正理由：

【請求項 1,3,5,8】

【請求項 2,6 刪除】

【請求項 11~20 刪除】

【請求項 9~12 新增】

(修正理由請參申復說明書)

### 四、附送書件：

( \* 個人資料保護注意事項：

申請人已詳閱申請須知所定個人資料保護注意事項，並已確認檢附之說明書、圖式、修正說明書、申復書及其附件(除委任書外)，不包含應予保密之個人資料；其載有個人資料者，同意智慧財產局提供任何人以自動化或非自動化之方式閱覽、抄錄、攝影或影印。)

1、本專利修正申請書 1 份。

2、發明專利修正部分劃線之摘要、說明書、申請專利範圍修正頁 1 份 (請於每頁右上角註記送件申請修正之日期)。

3、發明專利修正後無劃線之摘要、說明書、申請專利範圍及圖式替換頁各 1 份(請於每頁右上角註記送件申請修正之日期)。

4、申復書 1 份。

## 五、發明專利修正申請及規費之說明：

(一) 申請案(再審查案)發給第一次審查意見通知前，提出本次修正申請專利範圍者：

本案尚未提出實體審查申請，應繳規費不變。

本案已提出實體審查(再審查)申請，本次僅修正請求項，未有新增或刪除請求項之情事，應繳規費不變。

本案已提出實體審查(再審查)申請，本次有新增或刪除請求項者：

新增 ( ) 項，刪除 ( ) 項，修正後共計 ( ) 項。

本次應  加收或  退還規費共計新臺幣 ( ) 元整。

(二) 申請案(再審查案)發給審查意見通知後，提出本次修正申請專利範圍者：

本次僅修正或刪除請求項，未有新增請求項之情事，應繳規費不變。

本次有新增請求項者：

新增 ( 2 ) 項與修正前合計共 ( 11 ) 項。

本次應加收規費共計新臺幣 ( 800 ) 元整。

(三) 申請案(再審查案)提出本次修正後有新增說明書、申請專利範圍、摘要或圖式頁數，使修正後之說明書、申請專利範圍、摘要或圖式總頁數超過 50 頁者：

本次修正後總頁數與修正前總頁數已繳納之規費相較，並無加收超頁費之情事，應繳規費不變。

本次修正後總頁數與修正前總頁數已繳納之規費相較，有加收超頁費之情事，應加收規費計新臺幣 ( ) 元整。

## 申復理由書

- (一) 貴局 101 年 12 月 3 日審查意見通知函敬悉。
- (二) 修正事項說明：
- 1、發明名稱修正為「半導體裝置之製造方法」，使其與申請專利之發明標的一致。
  - 2、將說明書及申請專利範圍中所用之「熱處理」，修正統一為說明書實施例第[0022]段所記之用語「退火處理」。
  - 3、將請求項 2,6「溫度介於攝氏 500~750 度間」之技術併入請求項 1,5，以與貴局所援引證區隔。
  - 4、將請求項 3,8 誤植之「，」修正為「。」以符規定。
  - 5、為刪除半導體裝置之請求，爰將請求項 11~20 刪除。
  - 6、新增請求項 9~12 係分別依附於請求項 1,5，其所進一步界定之技術可見於說明書第[0028]段之實施例內容所記之金屬矽化物遮罩層材料之選用群組及最佳為氧化矽，並未超出原申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭示之內容。

(三) 關於本案所請發明具進步性之理由

- 1、 貴局所援引證 1,2，均未揭示或教示本案修正後之「第二次退火處理之溫度介於攝氏 500~750 度間」之技術，並且從本案說明書實施例第[0030]至[0032]段及圖 5 可以明確看出在該溫度間的退火處理具有降低金屬矽物電阻之功效。
- 2、 引證 1 雖揭示了在源/極使用鎳金屬矽化物的技術，但是本案所請之使用鈷為源/極使用金屬矽化物與其明顯不同，…。
- 3、 雖然貴局以引證 2 補足引證 1 未揭示之部分技術，然而其所揭示之多次退火之技術，仍與本案所載並且經過前後兩次不同溫度退火處理之技術不同，…。
- 4、 引證 1,2 間也完全沒有合理的組合動機，…。

(四) 綜上所陳，經由上述之修正使本案所請各項發明符合專利法之規定，並且相於引證 1,2，修正後之請求發明之製法步驟有較高的良率，不僅能避免習知接觸不良的缺失，且更能達到降低金屬矽化物電阻值之效果，實非發明所屬領域之通常知識者依引證 1,2 所能輕易完成者，應具有進步性。